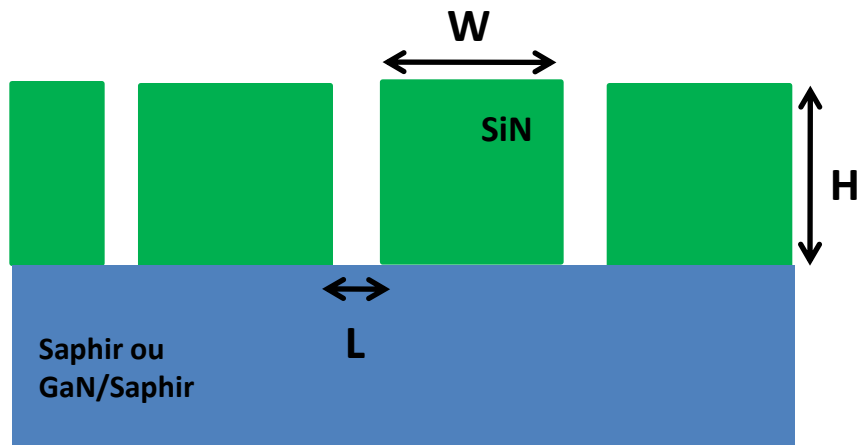


Aspect ratio trapping applied to stacking faults blocking in semipolar GaN

(CRHEA – CNRS)

Echantillons

- 2 (tests)+ 3 wafers 2 pouces Saphir plan M
- 1 (test)+ 2 wafers 2 pouces de template GaN/Saphir



Lithographie optique (deep UV?) de lignes de $1\mu\text{m}$ ($=L$) gravées dans le SiN ($H=2,5\mu\text{m}$) (jusqu'au saphir ou GaN suivant le type d'échantillon) séparés de $5\mu\text{m}$ de large ($=W$) . **La direction de ces lignes doit être perpendiculaire au méplat du wafer lors de la lithographie.** Il est indispensable qu'il n'y ait plus de SiN au fond des lignes pour garantir la croissance par la suite.

$R = H/L \geq 2$ au final C'est-à-dire pour 2500nm de SiN on doit avoir $L \leq 1000\text{nm}$. (si les flancs du masque sont droits)

